

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 9 日 (09.09.2005)

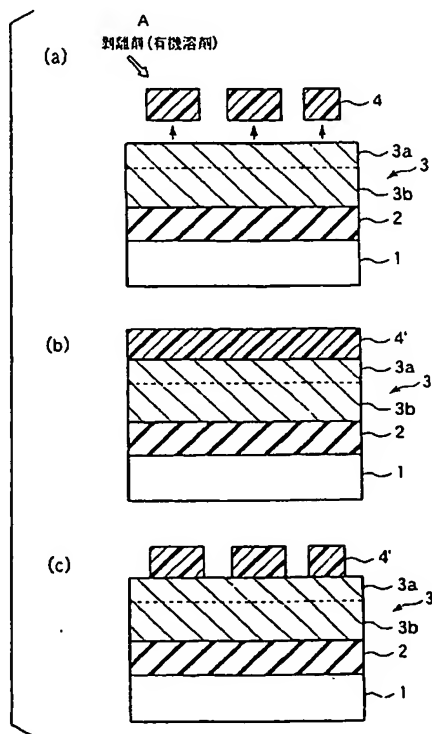
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/083757 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/027, [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号
G03F 7/42, H01L 21/304 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/003392 (72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 芦垣 繁雄
(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 1 日 (01.03.2005) (ASHIGAKI, Shigeo) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県
(25) 国際出願の言語: 日本語 山梨県市穂坂町三ツ沢 650 番地 東京エレクトロン
(26) 国際公開の言語: 日本語 A T 株式会社内 Yamanashi (JP). 加藤 良裕 (KATO,
Yoshihiro) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県市穂坂町
(30) 優先権データ: 三ツ沢 650 番地 東京エレクトロン A T 株式
特願2004-056629 2004 年 3 月 1 日 (01.03.2004) JP 会社内 Yamanashi (JP). 廣田 良浩 (HIROTA, Yoshihiro)
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エ [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号
レクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 村木 雄介
(MURAKI, Yusuke) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県市穂坂町三ツ沢 650 番地 東京エレクトロン A T
株式会社内 Yamanashi (JP). 川崎 哲 (KAWASAKI, Tetsu) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県市穂坂町三ツ
- [続葉有]

(54) Title: METHOD FOR SEPARATING RESIST FILM AND REWORK PROCESS

(54) 発明の名称: レジスト膜の剥離方法およびリワーク方法



A - REMOVER (ORGANIC SOLVENT)

(57) Abstract: Disclosed is a method for processing a substrate comprising a step for sequentially forming an Si-C film and a resist film on an object film to be etched which is formed on a substrate, a first etching step for etching the Si-C film using the resist film as a mask, and a second etching step for etching the object film using the resist film and the Si-C film as a mask. This method further comprises a separation step at a desired timing wherein the resist film is separated. The separation step has a preparation sub-step for preparing an organic solvent as a remover, and an application sub-step for applying the organic solvent to the resist film.

(57) 要約: 本発明は、基板に形成されたエッチング対象膜の上に、Si-C系膜と、レジスト膜と、を順次形成する工程と、前記レジスト膜をマスクとして前記Si-C系膜をエッチングする第1エッチング工程と、前記レジスト膜および前記Si-C系膜をマスクとして前記エッチング対象膜をエッチングする第2エッチング工程と、を備えた基板の処理方法に関する。本方法は、所望のタイミングにおいて前記レジスト膜を剥離する剥離工程を更に備える。前記剥離工程は、剥離剤としての有機溶剤を用意する準備工程と、前記有機溶剤を前記レジスト膜に適用する適用工程と、を有する。